REDUCTION OF UNCONTROLLABLE SPILLED BEAM IN RF-KO SLOW-EXTRACTION

Kota Mizushima^{A), B)}, Toshiyuki Shirai^{A)}, Takuji Furukawa^{A)}, Shinji Sato^{A)}, Yoshiyuki Iwata^{A)}, Koji Noda^{A)},

Hiroshi Uchiyama^{C)}, Takashi Fujisawa^{C)}

^{A)} Department of Accelerator and Medical Physics, National Institute of Radiological Sciences,

4-9-1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba 263-8555

^{B)} Graduate School of Sciences and Technology, Chiba University,

1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba 263-8522

^{C)} Accelerator Engineering Corporation,

2-13-1 Konakadai, Inage-ku, Chiba 263-0043

Abstract

The RF-KO slow-extraction method has been used for fast on/off switching of the beam from the synchrotron during scanning irradiation at HIMAC. However, the controllable low beam rate is limited by a small amount of beam which spilled out without the transverse RF field. We could reduce it to 0.4% compared to the original method by adding the another transverse RF field with a frequency component matched with the betatron frequency of particles near the stopband.

RF-KO取り出しにおける漏れビーム減少法の研究

3

1.はじめに

1993 年、放射線医学総合研究所にがん治療用加 速器としてHIMAC (Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba) [1]が建設され、重粒子線、特に炭素イオンを 用いたがん治療の臨床試行が 1994 年から行われて いる。重粒子線治療の特徴としてブラッグ・ピーク 周りの高い線量集中性と生物効果があり、その特徴 を最大限に生かすためにHIMACでは、走査型照射 野形成法[2]と呼吸同期照射法[3]を用いた3次元ス キャニング照射法[4]が開発された。その照射法には、 位置と線量の高い照射精度と早いビームのオン・オ フ制御が求められ、それらに答えるRF-knockout (RF-KO) による遅い取り出し法[5]の開発が行われ ている。その取り出し法は、三次共鳴と周波数変調 (FM)を用いた横方向高周波電場による拡散により セパラトリクス内の粒子を取り出すものである。し かし、セパラトリクス近傍に存在する粒子は、シン クロトロン振動による運動量変化や電磁石の電源リ ップルなどにより、横方向高周波電場がなくても取 り出されてしまう。その漏れビームが低い取り出し レートを制限してしまう。

漏れビームを減らすために、セパラトリクス近傍 の粒子のベータトロン振動数に合わせた単一周波数 の横方向高周波電場を従来の電場に加えることで、 照射中にセパラトリクス近傍の粒子を選択的に取り 出すことができる[6]。本研究では、シミュレーショ ンと実験によりセパラトリクス近傍の粒子密度が単 一周波数電場により下げられ、漏れビームを減らせ ることを実証した。

2.シミュレーションによる検証

単一周波数電場 (Mono-RF field) の効果を調べる ために、表1に示したようなパラメーターでトラッ キングシミュレーションを行った。FMを用いた高 周波電場 (FM-RF field) は六極電磁石によって生み 出されたセパラトリクス内部のチューンスプレッド を持つビームを拡散させるために用いる。そのFM の周波数帯域は、3.676 から 3.680 のチューンに対 応する。

表 1			シ	ミュ	レー	シ	з>)	パラ	メ	ーター	
-----	--	--	---	----	----	---	----	---	----	---	-----	--

Beam	$^{12}C^{6+}$ 350 MeV/n
Betatron tune	(3.680, 3.113)
Momentum spread (1σ)	$2.5 imes 10^{-4}$
Horizontal chromaticity	-0.5
Revolution frequency (f _{rev})	1.589 MHz
Longitudinal RF-frequency	$6.355 \text{ MHz} = 4 \times f_{rev}$
Frequency of FM-RF field	1.074 to 1.080 MHz
Frequency of Mono-RF field	1.069 MHz
Max kick angle by RF-KO	4.0 μrad

シミュレーションの条件は、(1) 100 ms間ビーム を取り出した後、(2) 30 ms間ビームを止める。ビー ム停止は、HIMACでの実際の治療と同様に、RF-KO電圧を切るだけでなく高速四極電磁石を励磁す ることで共鳴条件から引き離して行う。(2)の後、 (3) 高速四極電磁石を切り、横方向高周波電場がな くてもセパラトリクスからこぼれる粒子(漏れビー ム粒子)を調べる。単一周波数電場を用いず取り出 したときのシミュレーション結果は図1(a)のように なった。(3)で粒子がわずかにこぼれ、それらはシン クロトロン振動に起因するため、そのパルス幅がシ ンクロトロン振動数 1.55 kHzに対応する 0.7 msであ ることがわかる。その漏れビーム粒子を規格化位相 空間で見ると、(2)の直前で図 2 (a)のようにセパラ トリクス近傍に分布していたことがわかった。さら に、それらの粒子のターンごとの位置をフーリエ変 換した結果を図 2 (b)に示した。続いて、図 2 (b)の ピークに合わせて決めた単一周波数電場を加えた場 合のシミュレーションを行い、その結果は図 1 (b)の ように元の方法の 4.5% に漏れビーム粒子を減らす ことができた。



図1:(a)単一周波数電場を加えなかった場合と、 (b)単一周波数電場を加えた場合におけるビームス ピルのシミュレーション結果。



図 2 :漏れビーム粒子の(a) 規格化位相空間分布と (b) フーリエ空間分布。

3.HIMACにおける実験結果

実際には、電磁石の電源リップルなども漏れビームに影響するが、シミュレーションでその効果を見積もることは難しいので、HIMACでの350 MeV/nの ¹²C⁶⁺ビームを用いた実験により単一周波数電場を加える効果を調べる。リング内の周回粒子数は1× 10¹⁰ 個で、取り出しビームレートは5×10⁸ pps (particles per second) である。シミュレーションの条件のように、(1)1 s間ビームを取り出した後、(2)1 s 間ビームを止め、(3) 高速四極電磁石を切ってから 100 ms間にこぼれる粒子を測定シタ。FMの周波数 帯域は1.079 MHzから1.082 MHzで、その他のパラ メーターは表1と同じである。図3に示されたブロ ックダイアグラムのように、二つの電離箱をビーム ラインの終端に置いた。一つは漏れビーム粒子数を 測るために、そして、もう一つは取り出しビーム強度のフィードバック制御[7]のために置かれた。そのフィードバックシステムは、RF-KO電圧を制御することで取り出しレートを一定に保つ。従来の単一周波数電場を用いない取り出し法によるビームスピルが図4に示され、その漏れビームレートは7.6×10⁸ ppsであった。



図3:実験セットアップのブロックダイアグラム



図4:単一周波数電場を用いない従来の取り出し法 でのビームスピル。

図5に、高周波電場の周波数を1.072 MHzから 1.075 MHzの間で、チューンにすると3.675 から 3.677 の間で変えたときの漏れビームレートの変化 を示した。単一周波数電場とFM高周波電場の電圧 比は1:1である。図中の破線は、単一周波数電場 を加えなかったときの漏れビームレートを示してい る。漏れビームを少なくできる最適な高周波電場の 周波数は1.074 MHzであった。さらに図6に、1.074 MHzの単一周波数電場のFM高周波電場に対する電 圧比を上げていったときの漏れビームレートの変化 を示した。単一周波数電場の電圧比が5.3 倍のとき、 漏れビームレートは3×10⁶ ppsで、従来の取り出し 法の0.4%に抑えることができた。図7に電圧比が4 倍のときのビームスピルを示す。



図5:単一周波数電場の周波数と漏れビームレート の依存性。



図6:単一周波数電場と FM 高周波電場の電圧比と 漏れビームレートの依存性。



図7:1.074 MHzの単一周波数電場を FM 高周波電場と4倍の電圧比で加えた場合のビームスピル。

リング内の非破壊2 D ビームプロファイルモニ ター[8]を用いて、単一周波数電場の粒子密度分布に 与える効果を調べた。ビーム取り出し中の0.3 ms間 にプロファイルモニターにより測定した結果とその 水平方向の密度分布を図8に示す。図8(a)に示され た単一周波数電場を加えていない場合のプロファイ ルに比べ、電圧比が5.3 倍の単一周波数電場を加え た図8(b)の結果は、明らかに端部の粒子密度が下げ られている。

4.まとめと今後

今回の実験で、加える単一周波数電場の周波数最 適化とFM高周波電場との電圧比を上げることで、 従来の取り出し法と比較して 0.4%に漏れビーム量 を減らすことができた。また、非破壊2Dビームプ ロファイルモニターを用いることで、実際にリング 内の水平方向粒子分布端部の密度を単一周波数電場 により下げられていることも確認できた。この取り 出し法は、何度も加減速を行うエネルギー可変化取 り出し運転[9]においてエミッタンス増加により生じ るビームロスの減少にも、その端部の密度低下によ り効果があると期待できる。



図8:非破壊2Dビームプロファイルモニターに よる、(a)単一周波数電場を加えなかった場合と、 (b) 1.074 MHzの単一周波数電場をFM高周波電場と 5.3 倍の電圧比で加えた場合の測定結果と、(c)それ らの水平方向密度分布。

5.謝辞

本研究で加速器の運転に協力して頂いたAECの皆 さんと、非破壊2Dプロファイルモニターに関して 協力して頂いたKEKの橋本義徳さんに深く感謝いた します。

参考文献

- [1] Y. Hirao et al., Nucl. Phys. A, 538 (1992) 541.
- [2] E. Urakabe et al., Jpn. J. Appl. Phys. 40 (2001) 2540.
- [3] S. Minohara et al., Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 47 (4) (2000) 1097.
- [4] T. Furukawa et al., Proc. of EPAC08, Genoa, (2008) 1794.
- [5] K. Noda et al., Nucl. Instr. and Meth. A 492 (2002) 241.
- [6] K. Mizushima et al., Nucl. Instr. and Meth. A 489 (2002) 59.
- [7] S. Sato et al., Nucl. Instr. and Meth. A 574 (2007) 226.
- [8] Y. Hashimoto et al., Nucl. Instr. and Meth. A 527 (2007) 289.
- [9] Y. Iwata et al., Proc. of EPAC08, Genoa, (2008) 1800.